Datasheet World

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)					電気的特性 (Ta=25°C)												外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO}最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルスh_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)		
1	2	3	4	5					6		7		8						9	10	11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO ·····

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)	外形	備考
2SC1034	ソニー	PA. SW	Si. TMe	1100	13	1A	25W (Tc=25°C)	150	5 mA	800	18	3	750	10	−200					5 *	95	$C_c r_{bb'}$ 220pS	100	
★ 〃 1035	三洋	LN	Si. TP	30	3	20	150	150	1	25	100	6	1	6	−3	NF = 6 dB (f = 800MHz, 11V, 2mA)				700 *	0.7	$C_c r_{bb'}$ 2.5pS	205C	
★ 〃 1036	〃	RF	〃	30	3	20	150	150	1	25	100	6	1	6	−3					700 *	0.7	$C_c r_{bb'}$ 2.5pS	205C	
〃 1037	日電	PA	Si.E	60	4	4A	50W (Tc=25°C)	175	1 mA	30	50	10	1A			P_o = 33W (f = 160Mc, V_{cc} = 28V, P_i = 10W)							111	
〃 1038	〃	〃	〃	40	3	150	3.75W (Tc=25°C)	175	50	20	15~200	10	70	10	−70	P_o = 800mW (f = 2.3GHz, V_{cc} = 18V, P_i = 250mW)				2000 *	2.5		129	
〃 1039	〃	〃	〃	40	3	250	7.5W (Tc=25°C)	175	100	20	15~200	10	100	10	−100	P_o = 1.4W (f = 2.3GHz, V_{cc} = 18V, P_i = 630mW)				2000 *	4		129	
〃 1040	〃	〃	〃	45	4	1.2A	15W (Tc=25°C)	175	1 mA	30	15~200	10	1A			P_o = 8 W (f = 500MHz, V_{cc} = 18V, P_i = 2W)							184	
〃 1041	〃	〃	〃	40	3	150	3.75W (Tc=25°C)	175	50	20	15~200	10	70	10	−70	P_o = 900mW (f = 2GHz, V_{cc} = 18V, P_i = 250mW)				2000 *	2.5		129	
〃 1042	〃	〃	〃	40	3	250	7.5W (Tc=25°C)	175	100	20	15~200	10	100	10	−100	P_o = 1.6W (f = 2GHz, V_{cc} = 18V, P_i = 630mW)				2000 *	4		129	
〃 1043	〃	RF. LN	〃	45	3	300	6W (Tc=25°C)	175	0.1	30	80	10	100	15	−50	Pc = 15dB (f = 500MHz, 50mA) NF = 3.5dB (f = 200MHz, 50mA)				2200 *	2.5		129	
〃 1044	〃	RF	〃	45	4	30	250	200	50nA	30	100	6	6	6	−6	Gp = 22dB (f = 200MHz)				1000 *	NF = 3dB (f = 200MHz)		50C	
★ 〃 1045	三洋	RF.PA	Si. T	1000	5	1A	25W (Tc=25°C)	125	5	100	25~200	15	200											
★ 〃 1046	〃	PA	Si. TMe	1000	6	3A	25W (Tc=25°C)	150	100	100	8	5	2A	5	−100	t_f < 1.5μS				4 *	150	35	102	
〃 1047	松下	RF	Si. EP	30	3	15	150	125	10	30	120	6	1	6	−1					650 *	Cre 0.88pF	30	138	
★ 〃 1048	三洋	〃	Si. Me	200	6	50	600	150	10	100	90	10	25	10	−10					120 *	3.5		84B	
〃 1049																								
〃 1050	三洋	PA	Si. TMe	300	6	1A	40W (Tc=25°C)	150	1 mA	150	90	5	300	5	−300					5 *	50		102	
〃 1051	〃	〃	〃	150	6	7A	60W (Tc=25°C)	150	1 mA	30	90	5	1A	5	−1A					8 *	230		102	
★ 〃 1052	富士通	SW	Si. EP	75	5	1A	800	175	0.5	50	40	1	500			t_{on} < 50nS, t_{off} < 70nS t_{stg} < 40nS							84B	
★ 〃 1053	〃	〃	〃	75	5	700	800	175	0.2	40	50	1	500			t_{on} < 40nS, t_{off} < 60nS t_{stg} < 45nS							84B	
★ 〃 1054	〃	RF. LN	〃	35	3	50	180	175	0.5	12	60	6	1	6	−2	NF = 3dB (f = 200MHz, 6V, 1mA)				700 *	1	30 *	205C	
〃 1055	日立	PA. SW	Si. T	130	6	7A	25W (Tc=25°C)	175	200	30	60	4	5A			t_{on} = 0.4μS, t_{off} = 4μS t_{stg} = 35μS							153	
★ 〃 1056	ソニー	RF	Si.PaMe	260	5	100	750	175	1	100	150	5	3	20	−20					180 *	7		181	
★ 〃 1057	富士通	PA	Si. EP	50	3.5	1A	12W (Tc=25°C)	175	500	20	50	5	500			P_o = 6.5W (V_{cc} = 24V, f = 700MHz, P_i = 2W)							133	
★ 〃 1058	〃	〃	〃	50	3.5	2A	20W (Tc=25°C)	175	1 mA	20	50	5	1A			P_o = 11.5W (V_{cc} = 24V, f = 700MHz, P_i = 4W)							133	
★ 〃 1059	日立			300	4	150	8W (Tc≦70°C)	150			60	10	50										153	
〃 1060	〃	PA	Si. T	50	4	3A	25W (Tc=25°C)	150	100	20	35~320	4	1A	4	−500					8 *	100		267	2SA670 とコンプリ
〃 1061	〃	〃	〃	50	4	3A	25W (Tc=25°C)	150	100	20	35~320	4	1A	4	−500					8 *	100		268	2SA671 とコンプリ
〃 1062	富士通 日電	SW	Si. TMe	200	4	100	700	175	2	100	60	2	50			t_{on} < 3.2μS, t_{off} < 12μS t_{stg} < 8μS					5		84B	
★ 〃 1063	ソニー	〃	Si. DB	10	5	1A	750	150	1	10	60	1	65			t_r < 60nS, t_f < 100nS t_{stg} < 300nS							84C	